

	<h2 style="color: #E67E22;">SIS439DNT-T1-GE3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS439DNT-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 16166 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

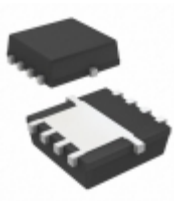
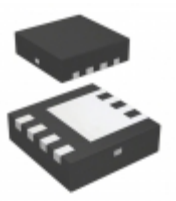






### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	16166 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 14A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52.1W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2135pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SIS439DNT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS439DNT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS439DNT-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS439DNT-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>SIS438DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 16A PPAK 1212-8	 <b>SIS439DNT-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8	 <b>SIS443DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 35A PPAK 1212-8	 <b>SIS443DN-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAK1212
 <b>SIS444DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A POWERPAK1212	 <b>SIS4407</b> SIS SIS4407 SIS	 <b>SIS443DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 35A PPAK 1212-8	 <b>SIS436DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 16A PPAK 1212-8

### SIS439DNT-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>
<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>
<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>
<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>	<a href="#">SIS439DNT-T1-GE3</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited